

判決年月日	平成１８年１０月１１日	担当部	知的財産高等裁判所 第４部
事件番号	平成１７年(行ケ)１０７１７号		
○ 名称を「有機発光素子用のカプセル封入材としてのシロキサンおよびシロキサン誘導体」とする発明につき，引用発明に基づき当業者が容易になし得た発明であるとした審決の判断が誤りであるとして，当該審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法２９条２項

上記発明に係る特許出願についての拒絶不服審判において，審決が対象とした本願発明（請求項１記載の発明）は，「発光部分がシロキサンで覆われ(る)」ことを要件とする「有機発光素子」の発明であるところ，審決は，本願発明と主引用例記載の発明（引用発明１ａ，引用発明１ｂ，引用発明１ｃ，引用発明２の４例が挙示された。）との相違点として，発光部分を覆う被覆層が「本願発明ではシロキサンであるのに対し，引用発明１ａではオーバーコート層（引用発明１ｂでもオーバーコート層，引用発明１ｃでは基板兼光散乱部，引用発明２ではプラスチック基板）である点」を挙げた上，副引用例に「有機発光素子の封止機能を有する保護層としてのシロキサン」を備えた引用発明３が記載されており，これも発光部分を覆うものであるから，引用発明１ａの「オーバーコート層」（引用発明１ｂの「オーバーコート層」，引用発明１ｃの「基板兼光散乱部」，引用発明２の「プラスチック基板」）に替えて，引用発明３のシロキサンを用いることは，当業者が容易に想到し得た事項であるとし，他の相違点についても容易想到とした上，本願発明は特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないと判断した。

なお，本件において，原告は，審判請求後に，他から特許を受ける権利の譲渡を受けたものであるが，譲渡時の不手際により，審判長からなされた拒絶理由通知に対する応答をしなかったため，審決は，拒絶理由通知を引用するごく簡単な理由が付されただけであった。そのため，本訴に至って，被告特許庁から最初に提出された準備書面で，詳細な審決の理由が主張された。上記の「審決の判断」は，同準備書面で主張されたものを含んでいる。

本判決は，下記のとおり判示して，引用発明３の「シロキサン」を引用発明１ｂの「オーバーコート層」（引用発明１ａの「オーバーコート層」，引用発明１ｃの「基板兼光散乱部」，引用発明２の「プラスチック基板」）に替えて用いることは，当業者が容易になし得たとはいえないから，審決の上記相違点についての判断を誤りであると判断し，審決を取り消した（引用発明１ｂとの相違点についての判断に対する部分のみを掲げるが，他の引用発明との相違点についての判断に関しても，ほぼ同旨である。）。

「引用発明１ｂの発光部分が被覆層に覆われているといえることは，上記１の(１)のとおり

りであり、刊行物 1、3 の各記載によれば、引用発明 3 においても発光部分が被覆層に覆われているといえること、引用発明 1 b 及び引用発明 3 が有機発光素子という同一技術分野に属していることも、被告主張のとおりである。しかしながら、刊行物 1 の・・・との記載によれば、引用発明 1 b のオーバーコート層は、光散乱部の凹凸面上に直接有機発光素子を形成した場合における、光散乱部の凹凸の影響による発光面の多数のダークスポットの発生やショートパスによる断線などを避けるため、光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化する目的で形成するものであることが認められる。他方、刊行物 3 の・・・との各記載によれば、引用発明 3 のシロキサンは、有機発光素子の外表面にシールド層を形成する際の影響から有機発光素子を保護すること等を目的とする保護膜として設けられるものであり、保護層形成過程での発光層や対向電極の特性劣化をできるだけ抑止するために、CVD 法により真空環境下で形成されることが特に好ましいことが認められる。また、・・・乙第 1 号証には、一般に CVD 法（プラズマ CVD 法）によって成膜された酸化膜は極めて薄く、平坦化目的には適さないことが記載されている・・・。

そして、刊行物 1 の上記記載によれば、引用発明 1 b のオーバーコート層は、光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化し得るものでなければならぬが、引用発明 3 のシロキサンが、その形成方法や膜厚を含めて平坦化に適した特質を有することを認めるに足りる証拠はなく、却って、上記刊行物 3 の記載や・・・の記載に照らすと、平坦化には適さないことが窺われる。そうすると、たとえ、引用発明 1 b も引用発明 3 も発光部分・・・が被覆層（引用発明 1 b のオーバーコート層、引用発明 3 のシロキサン）に覆われているものであり、また、引用発明 1 b と引用発明 3 とは、有機発光素子という同一技術分野に属しているとしても、それだけでは、引用発明 1 b のオーバーコート層に換えて引用発明 3 のシロキサンを用いることが、当業者にとって容易になし得たと論理付けることはできない。

被告は、・・・に見られるように、平坦化膜としてシロキサンを用いることは従来周知の技術事項であると主張するが、・・・は、上記のとおり、CVD 法（プラズマ CVD 法）によって成膜された酸化膜が極めて薄いため、平坦化目的には適さないとするものであって、そのシロキサンによる平坦化層の形成方法・・・は、CVD 法によりなされるものではない。このことは、・・・記載のシロキサンによる層形成・・・においても同様である。しかも、これらの刊行物に記載される平坦化膜は、引用発明 1 b や引用発明 3 のような有機発光素子装置ではなく、半導体装置に形成されるものであるところ、保護層形成過程において受けるダメージに関して、有機発光素子を、半導体素子と同様に扱ってよいことが知られていると認めるに足りる証拠もない。そうすると、上記各刊行物に、半導体装置において、CVD 法以外の方法により、シロキサンを用いた平坦化膜の形成が記載されているからといって、これに従って、上記のとおり、・・・「長寿命の有機 EL 素子を得るうえからは、保護層の形成過程での発光層や対向電極の特性劣化をできるだけ抑止することが望ましく、そのためには PVD 法や CVD 法により真空環境下で保護層を設けることが特に好ましい」との記載のある刊行物 3 に開示されたシロキサンの保護膜を、真空

環境下におけるＣＶＤ法以外の方法により形成して、引用発明１ｂのオーバーコート層に代わる平坦化膜に使用することが、当業者に容易になし得るものとは認めることができない。

なお、被告は、引用発明１ｂのオーバーコート層を引用発明３のシロキサンに置き換えて用いることは、より良い材料を試みようとする当業者にとって当然のことであるとも主張するが、上記のとおり、引用発明３のシロキサンが、平坦化に適した特質を有するものとは認められないのであるから、これを引用発明１ｂのオーバーコート層に代わる「より良い材料」ということはできないのであって、被告の上記主張を採用することもできない。」